

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-043618
 (43)Date of publication of application : 08.02.2002

(51)Int.CI. H01L 33/00
 C23C 16/34
 H01L 21/205
 H01S 5/343

(21)Application number : 2000-220454 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

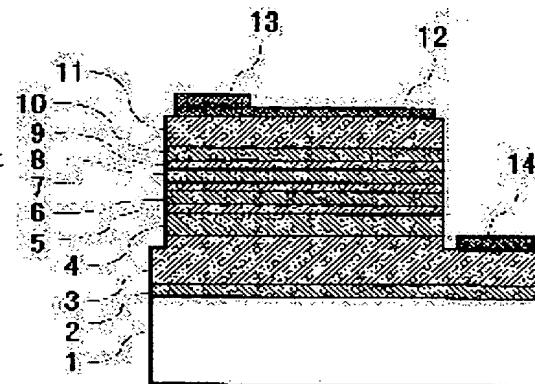
(22)Date of filing : 21.07.2000 (72)Inventor : TAKEISHI HIDEKI
 KAMEI HIDENORI
 SHINAGAWA SHUICHI

(54) METHOD FOR MANUFACTURING NITRIDE SEMICONDUCTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing an MQW light emitting layer improved in light emitting efficiency by suppressing a deterioration of a well layer and improving crystallinity of a barrier layer, and to provide a method for manufacturing a light emitting element at a low cost by shortening a forming time of the MQW light emitting layer.

SOLUTION: The method for manufacturing an MQW light emitting layer comprises the steps of growing parts of barrier layers 6, 8 and 10 while raising the temperature of the layers 6, 8 and 10 after the well layers 5, 7 and 9 are grown, and again repeating temperature raising and lowering steps after the parts of the layers 6, 8 and 10 are grown at a constant temperature. Thus, the MQW having excellent crystallinity and high light emitting efficiency can be formed. Further, the method for manufacturing the light emitting element comprises the steps of growing parts of the barrier layers 6, 8 and 10 while raising the temperatures of the layers 6, 8 and 10 after the well layers 6, 8 and 10 are grown, further accelerating the growth rate in the case of growing the parts of the layers 6, 8 and 10 at a constant temperature. Thus, a forming time of the MQW light emitting layer can be shortened, and a manufacturing cost of the emitting element can be reduced.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-43618

(P2002-43618A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51)Int.Cl.⁷
H 01 L 33/00
C 23 C 16/34
H 01 L 21/205
H 01 S 5/343

識別記号

F I
H 01 L 33/00
C 23 C 16/34
H 01 L 21/205
H 01 S 5/343

テ-マコ-ド(参考)
C 4 K 0 3 0
5 F 0 4 1
5 F 0 4 5
5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 11 頁)

(21)出願番号 特願2000-220454(P2000-220454)

(22)出願日 平成12年7月21日(2000.7.21)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 武石 英見

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 亀井 英徳

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

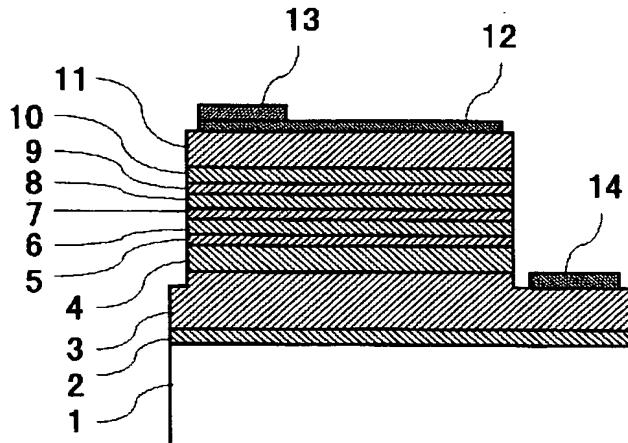
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 空化物半導体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 井戸層の劣化を抑制し、障壁層の結晶性向上させることで、発光効率の向上したMQW発光層の製造方法を提供することと、MQW発光層の形成時間の短縮化により製造コストを低減した発光素子の製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 井戸層5、7、9の成長後に、障壁層6、8、10の一部を昇温しながら成長し、さらに一定温度で障壁層6、8、10の一部を成長した後、再度降温する工程を繰り返すことにより、結晶性に優れ、発光効率の高いMQWを形成できる。さらに、井戸層5、7、9の成長後に、障壁層6、8、10の一部を昇温しながら成長し、さらに一定温度で障壁層6、8、10の一部を成長させる際に、成長速度を大きくすることにより、MQW発光層の形成時間を短縮化することができ、発光素子の製造コストを低減することが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】基板の上に、窒化物半導体からなる井戸層と、前記井戸層よりもバンドギャップエネルギーが大きい窒化物半導体からなる障壁層と、を交互に積層した多重量子井戸構造を有する窒化物半導体を製造する方法であって、第1の基板温度で前記井戸層を成長させる第1の工程と、前記第1の基板温度から前記第1の基板温度より高い第2の基板温度に向かって昇温しながら前記障壁層を成長させる第2の工程と、前記第2の基板温度から前記第1の基板温度に降温する第3の工程と、を順に繰り返すことによって多重量子井戸を形成することを特徴とする窒化物半導体の製造方法。

【請求項2】前記第2の工程により前記障壁層を成長させた後、前記第3の工程の前に、前記第2の基板温度を略一定に保った基板温度で更に前記障壁層を成長させる第4の工程を設けることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項3】前記第4の工程における前記障壁層の成長の少なくとも一部における成長速度が、前記第2の工程における前記障壁層の成長速度より大きいことを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項4】前記第4の工程における前記障壁層の成長時の少なくとも一部における雰囲気中の水素濃度が、前記第2の工程における前記障壁層の成長時の雰囲気中の水素濃度より大きいことを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項5】前記第4の工程における前記障壁層の成長時の少なくとも一部におけるIII族原料供給量に対するV族原料供給量の比（以下V/III比と呼ぶ）が、前記第2の工程における前記障壁層の成長時のV/III比より小さいことを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項6】前記井戸層が $I_{n_x}G_{a_{1-x}}N$ （但し、 $0 < x < 1$ ）であり、前記障壁層が $I_{n_y}A_{1-z}G_{a_{1-y-z}}N$ （但し、 $0 \leq y < 1$ 、 $0 \leq z < 1$ 、 $0 \leq y + z < 1$ 、 $x > y$ ）であることを特徴とする請求項1から5までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項7】前記障壁層が GaN であることを特徴とする請求項6に記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項8】前記第1の基板温度が $500^{\circ}\text{C} \sim 900^{\circ}\text{C}$ であり、前記第2の基板温度が $800^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$ であることを特徴とする請求項1から7までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項9】前記障壁層の成長開始時の Ga 原料供給量が、前記井戸層の成長時の Ga 原料供給量より少ないことを特徴とする請求項6から8までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項10】前記第3の工程において、前記第2の工程の少なくとも一部において、前記障壁層を成長させることを特徴とする請求項1から9までのいずれかに記載

の窒化物半導体の製造方法。

【請求項11】前記基板がサファイアまたは SiC を含み、前記第1の基板温度より低温の基板温度で前記基板の上に窒化物半導体を含むバッファ層を形成し、前記バッファ層の上に窒化物半導体を含む下地層を形成し、前記下地層の上に前記多重量子井戸を形成することを特徴とする請求項1から10までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項12】前記基板が窒化物半導体を含み、前記基板の上に窒化物半導体を含む下地層を形成し、前記下地層の上に前記多重量子井戸を形成することを特徴とする請求項1から10までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法。

【請求項13】前記基板が GaN であることを特徴とする請求項12に記載の窒化物半導体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は発光ダイオードや半導体レーザダイオード等の光デバイスに利用される窒化物半導体の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】III族元素として Al 、 Ga 、 In 等を含み、5族元素として N 等を含む $AlGaInN$ で表される窒化物半導体は、可視光の発光デバイスや高温動作電子デバイス用の半導体材料として多用されるようになっており、青色や緑色の発光ダイオードや、青紫色のレーザダイオードの分野で実用化が進んでいる。

【0003】この窒化物半導体を用いた発光素子の製造においては、有機金属気相成長（MOCVD）法によつて窒化物半導体薄膜結晶を成長させるのが近来では主流である。この方法は、サファイアや SiC 、 GaN 等からなる基板を設置した反応管内にIII族元素の原料ガスとして有機金属化合物ガス（トリメチルガリウム（以下、「TMG」と略称する。）、トリメチルアルミニウム（以下、「TMA」と略称する。）、トリメチルインジウム（以下、「TMI」と略称する。）等）と、V族元素の原料ガスとしてアンモニアやヒドラジン等を供給し、基板温度をおよそ $700^{\circ}\text{C} \sim 1100^{\circ}\text{C}$ の高温で保持して、基板上にn型層と発光層とp型層とを成長させてこれらを積層形成するというものである。n型層の成長時にはn型不純物原料ガスとしてモノシリコン（ SiH_4 ）やゲルマン（ GeH_4 ）等を、p型層の成長時にはp型不純物原料ガスとしてシクロペンタジエニルマグネシウム（ Cp_2Mg ）やジメチル亜鉛（ $Zn(CH_3)_2$ ）等をIII族元素の原料ガスと同時に流しながら成長させる。

【0004】そして、この成長形成の後、n型層の表面およびp型層の表面のそれぞれにn側電極およびp側電極を形成し、チップ状に分離することによって、発光素子を得ることができる。

【0005】発光層は、所望の発光波長となるようにInの組成を調整したInGaNを用い、これを発光層よりバンドギャップエネルギーの大きいクラッド層で挟み込んだダブルヘテロ構造や、更に発光層を量子サイズ効果が生じるような薄い層で形成した量子井戸構造が一般的に用いられているが、最近では、発光効率の高い量子井戸構造の方が主流となっている。

【0006】この量子井戸構造は井戸層と呼ばれるバンドギャップエネルギーの小さい層を井戸層よりもバンドギャップエネルギーの大きい層で挟み込むことによって形成される。

【0007】また、井戸層が一つである单一量子井戸よりも発光効率の高い多重量子井戸(MQW)は、In_xGa_{1-x}N(0 < x < 1)からなる井戸層と、In_yAl_{1-y}Ga_{1-y-z}N(0 ≤ y < 1, 0 ≤ z < 1, 0 ≤ y + z < 1, x > y)からなる障壁層を交互に積層することによって形成され、従来のMQWの作製方法としては以下の3通りに大別される。

【0008】第一の従来の技術は、特開平10-12922号公報に開示されている。これは、AlGaNからなる障壁層とInGaNからなる井戸層を交互に積層したMQWからなる窒化物半導体発光素子であり、MOCVD装置を用いて、サファイア基板上にAlNからなるバッファ層、SiをドープしたGaN層を順次に積層した後、MQWからなる発光層を積層し、その上にMgをドープしたクラッド層及びコンタクト層を順次に積層したものである。

【0009】この発光素子におけるMQWの成長方法については、まず基板温度を1100℃に保持し、N₂又はH₂、アンモニア、TMG、TMAを導入してAl_{0.05}GaN_{0.95}Nからなる厚さ50Åの障壁層を形成し、続いて基板温度を800℃に下げる保持し、N₂又はH₂、アンモニア、TMG、TMIを供給し、シリコンと亜鉛がドープされたIn_{0.20}GaN_{0.80}Nからなる厚さ50Åの井戸層を形成する。そして、前記障壁層と前記井戸層を交互に成長し、全体の厚さが0.055μmのMQWからなる発光層を形成する。この時、障壁層は井戸層の成長速度と同じにしている。

【0010】この構造では、発光層に井戸層と障壁層との歪超格子からなるMQWを用いているため、転位の少ない良質な結晶を得ることができ、窒化物半導体発光素子の発光効率が向上することが示されている。

【0011】第二の従来の技術は、特開平10-135514号公報に開示されている。これは、前記発光素子のMQWの成長方法において、基板温度を900℃に保持し、N₂、TMG、アンモニアを導入して厚さ3.5nmのGaNからなる障壁層を形成する。次に、基板温度を750℃に保持しN₂、TMG、アンモニアの他に、TMIを導入して厚さ3.5nmのIn_{0.16}GaN_{0.84}Nからなる井戸層を形成する。そして、前記障壁層

と前記井戸層を交互に成長し、5層の障壁層と井戸層を形成する。さらに、基板温度を900℃に保持し、14nmのGaNからなる最上の障壁層を5段目の量子井戸層上に形成する。この時、障壁層は井戸層の成長速度と同じにしている。

【0012】この構造では、SiドープのGaN層およびMgドープのクラッド層に接する側の層を障壁層とし、かつ各障壁層の厚みを均一にすることによって、発光する光の波長シフトが防止できることが示されてい

10 10。第三の従来の技術は、特開平11-224972号公報に開示されている。これは、前記発光素子のMQWの成長方法において、基板温度を750℃に保持して、In_{0.2}GaN_{0.8}Nからなる井戸層を25Åの膜厚で形成する。次に、TMIのモル比を変化させるのみで同じ基板温度で、In_{0.01}GaN_{0.99}Nからなる障壁層を50Åの膜厚で形成する。この操作を13回繰り返し、最後に井戸層を形成し、総膜厚が0.1μmの多重量子井戸構造からなる活性層を形成する。この時、障壁層は井戸層の成長速度と同じにしている。

20 20.【0013】この例では、障壁層を井戸層よりもバンドギャップの大きいInGaNとして形成したものであり、井戸層の上にInGaNからなる障壁層を形成した場合、InGaNからなる障壁層はGaNやAlGaN結晶に比較して結晶が柔らかいため、MQWよりも上のクラッド層にクラックが発生し難くなり、前記クラッド層を厚くできるため、特に窒化物半導体からなる半導体レーザの高品質化に有効であることが示されている。

【0014】また、障壁層もInGaNの場合、井戸層と障壁層が同じ温度で成長できるため、先に形成した井戸層の分解が抑制されるので、結晶性のよいMQWを形成できるし、井戸層と障壁層を連続して成長できるので、MQWの成長時間も短縮できることが示されている。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述のようなMQWの形成方法においては以下のようないくつかの問題点がある。

40 40.【0016】まず、第一の従来の技術においては、InGaNからなる井戸層を成長後、AlGaNからなる障壁層を成長させる基板温度(1100℃)まで昇温する過程において、井戸層が分解してしまうため、結晶性のすぐれた井戸層を成長させることは困難である。

【0017】次に、第二の従来の技術においても、InGaNからなる井戸層を成長後、GaNからなる障壁層を成長させる基板温度(900℃)まで昇温する過程において、少なくとも井戸層の分解が発生するため、結晶性のすぐれた井戸層を成長させることは困難である。

【0018】一方、第三の従来の技術においては、井戸層と障壁層を成長させる基板温度が同じであるため、井戸層の分解は少ない。しかしながら、MQWにおいて、

障壁層が十分機能するためには、障壁層は井戸層に比較して十分低いIn組成にする必要がある。この例では、障壁層のIn組成は0.01であり、このような低いIn組成を制御することは困難である。

【0019】また、前記障壁層のInGaNは、実質的にはGaNに近い結晶である。これより、GaNに近い結晶である障壁層を井戸層と同じ基板温度(750°C)で成長させることになるため、障壁層の結晶性は従来の技術の1100°C付近で成長した場合に比較して悪くなる。

【0020】このように、従来のMQWの製造方法では、障壁層の結晶性向上のために、障壁層を成長させる基板温度を井戸層を成長させる基板温度よりも上げると井戸層が劣化し、障壁層と井戸層を同じ基板温度で成長させると、障壁層の結晶性が不十分となり、MQWの品質が低下するという問題があった。

【0021】また、高品質なMQWを作製するためには、障壁層は井戸層に比較して厚く形成する必要がある。前記3つの従来の技術に共通するように、障壁層と井戸層を同じ成長速度で成長させる方法では、障壁層を厚くした場合やMQWの周期数を増やした場合に成長時間が長くなり、MQWの製造コストが高くなる上、MQWの結晶性が低下するという問題があった。

【0022】本発明において解決すべき課題は、井戸層の劣化を抑制し、かつ障壁層の結晶性を向上させることで、発光効率の向上したMQWの製造方法を提供することと、MQWの形成時間の短縮化により製造コストを低減した窒化物半導体からなる発光素子の製造方法を提供することである。

【0023】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、MQWの製造方法(特に、基板温度、成長速度、雰囲気の水素濃度及びV/III比)について鋭意検討を行った。その結果、井戸層の成長に適した基板温度で井戸層を成長した後に、基板を昇温しながら障壁層の一部(以下、「障壁層A」と略称する。)を成長し、さらに昇温後に略一定の基板温度で障壁層の一部(以下、「障壁層B」と略称する。)を成長した後、基板温度を井戸層を成長させる温度まで降温し、井戸層を成長させるといった工程を繰り返すことにより、結晶性に優れ、発光効率の高いMQW発光層を形成できることを見出した。

【0024】次に、障壁層Bを成長させる際に、雰囲気の水素濃度を障壁層Aを成長させる場合よりも高くすることや、V/III比を障壁層Aを成長させる場合によりすることによって、障壁層Bの結晶性を改善できることを見出した。

【0025】また、障壁層Bを成長させる際に、井戸層および障壁層Aよりも速い成長速度で成長させることや、障壁層Bを成長した後、井戸層を成長させる基板温度まで降温する際にも、少なくとも障壁層の一部を成長

させる工程を加えることによって、障壁層が厚い場合や、MQWの周期数が多い場合でも、MQWの形成時間がさらに短縮できることを見出した。

【0026】このような構成によれば、MQWの形成時において、井戸層の分解を抑制できると同時に、障壁層の結晶性を向上させることができ、発光効率の高いMQW発光層を作製することができる。また、MQW発光層の形成時間を短縮化することができるため、窒化物半導体からなる発光素子の製造コストを低減することができる。

【0027】

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、基板の上に、窒化物半導体からなる井戸層と、前記井戸層よりもバンドギャップエネルギーが大きい窒化物半導体からなる障壁層と、を交互に積層した多重量子井戸構造を有する窒化物半導体を製造する方法であって、第1の基板温度で前記井戸層を成長させる第1の工程と、前記第1の基板温度から前記第1の基板温度より高い第2の基板温度に向かって昇温しながら前記障壁層を成長させる第2の工程と、前記第2の基板温度から前記第1の基板温度に降温する第3の工程と、を順に繰り返すことによって多重量子井戸を形成することを特徴とする窒化物半導体の製造方法である。

【0028】この方法は、井戸層の成長直後より、昇温しながら障壁層を成長させるので、昇温時におけるInGaNからなる井戸層の分解が抑制できると同時に、障壁層の結晶性を高めることができるという作用を有する。

【0029】請求項2に記載の発明は、前記第2の工程により前記障壁層を成長させた後、前記第3の工程の前に、前記第2の基板温度を略一定に保った基板温度で更に前記障壁層を成長させる第4の工程を設けることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体の製造方法であり、井戸層を成長させる基板温度より高い基板温度で保持した状態において、障壁層の一部を成長させるので、障壁層の結晶性をさらに高めることができるという作用を有する。

【0030】請求項3に記載の発明は、前記第4の工程における前記障壁層の成長の少なくとも一部における成長速度が、前記第2の工程における前記障壁層の成長速度より大きいことを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法であり、井戸層よりも相対的に厚い障壁層や周期数の多いMQWを短時間で成長でき、トータルのMQWの成長時間を短縮できるため、MQWからなる窒化物半導体の製造コストを低減できるという作用を有する。

【0031】請求項4に記載の発明は、前記第4の工程における前記障壁層の成長時の少なくとも一部における雰囲気中の水素濃度が、前記第2の工程における前記障壁層の成長時の雰囲気中の水素濃度より大きいことを特

徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法であり、前記第4の工程で水素濃度を高めることにより、基板表面での原子のマイグレーションが促進され、障壁層の結晶性をさらに高めることができるという作用を有する。

【0032】請求項5に記載の発明は、前記第4の工程における前記障壁層の成長時の少なくとも一部におけるIII族原料供給量に対するV族原料供給量の比（以下V/III比と呼ぶ）が、前記第2の工程における前記障壁層の成長時のV/III比より小さいことを特徴とする請求項2に記載の窒化物半導体の製造方法であり、障壁層Bを成長させる際に、障壁層Bの結晶性を悪化させずにアンモニアの供給量を大幅に低減でき、MQWからなる窒化物半導体の製造コストを低減できるという作用を有する。

【0033】請求項6に記載の発明は、前記井戸層が $In_xGa_{1-x}N$ （但し、 $0 < x < 1$ ）であり、前記障壁層が $In_yAl_zGa_{1-y-z}N$ （但し、 $0 \leq y < 1$ 、 $0 \leq z < 1$ 、 $0 \leq y + z < 1$ 、 $x > y$ ）であることを特徴とする請求項1から5までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、井戸層及び障壁層を構成する窒化物半導体材料を上記の材料に限定することで、MQWを高品質化することができ、光学的特性のすぐれたMQWからなる窒化物半導体を作製できるという作用を有する。

【0034】請求項7に記載の発明は、前記障壁層が GaN であることを特徴とする請求項6に記載の窒化物半導体の製造方法であり、障壁層の結晶性をさらに高めることができ、光学特性のすぐれたMQWからなる窒化物半導体を作製できるという作用を有する。

【0035】請求項8に記載の発明は、前記第1の基板温度が500°C～900°Cであり、前記第2の基板温度が800°C～1200°Cであることを特徴とする請求項1から7までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、前記第1の基板温度および前記第2の基板温度を上記の範囲に限定することにより、結晶性のすぐれた井戸層及び障壁層を作製できるという作用を有する。

【0036】請求項9に記載の発明は、前記障壁層の成長開始時の Ga 原料供給量が、前記井戸層の成長時の Ga 原料供給量より少ないことを特徴とする請求項6から8までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、井戸層の劣化が抑制できると同時に、障壁層の結晶性を高めることができるという作用を有する。

【0037】請求項10に記載の発明は、前記第3の工程において、前記第2の工程の少なくとも一部において、前記障壁層を成長させることを特徴とする請求項1から9までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、降温時にも障壁層の一部を成長させることにより、特に障壁層を厚くする場合やMQWの周期数を多くする場合でもMQWの形成時間を短縮化することができ、MQWからなる窒化物半導体の製造コストを低減す

ることできるという作用を有する。

【0038】請求項11に記載の発明は、前記基板がサファイアまたはSiCを含み、前記第1の基板温度より低温の基板温度で前記基板の上に窒化物半導体を含むバッファ層を形成し、前記バッファ層の上に窒化物半導体を含む下地層を形成し、前記下地層の上に前記多重量子井戸を形成することを特徴とする請求項1から10までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、高い結晶性をもつ下地層を作製でき、その上に成長させる10 MQWを高品質化できるため、MQWからなる発光層をもつ窒化物半導体発光素子の発光効率を高めることができるという作用を有する。

【0039】請求項12に記載の発明は、前記基板が窒化物半導体を含み、前記基板の上に窒化物半導体を含む下地層を形成し、前記下地層の上に前記多重量子井戸を形成することを特徴とする請求項1から10までのいずれかに記載の窒化物半導体の製造方法であり、さらに高い結晶性をもつ下地層を作製でき、その上に成長させるMQWを高品質化できるため、MQWからなる発光層を20 MQWを高品質化できるため、MQWからなる発光層をもつ窒化物半導体発光素子の発光効率を高めることができるという作用を有する。

【0040】請求項13に記載の発明は、前記基板が GaN であることを特徴とする請求項12に記載の窒化物半導体の製造方法であり、基板と前記下地層が同一材料であるため、さらに高い結晶性をもつ下地層を作製でき、その上に成長させるMQWを高品質化できるため、MQWからなる発光層をもつ窒化物半導体発光素子の発光効率を高めることができるという作用を有する。

【0041】以下に、本発明の実施の形態の具体例を、30 図面を参照しながら説明する。

【0042】図1には、本発明の一実施の形態に係るMQWからなる窒化物半導体発光素子の層構造を表す断面図を示す。

【0043】この発光素子は、サファイアからなる基板1の上に、 GaN からなるバッファ層2と、 GaN からなる第1のn型クラッド層3と、 $AlGaN$ からなる第2のn型クラッド層4と、 $InGaN$ からなる井戸層5および GaN からなる障壁層6を交互に成長させたMQW層（5～10）と、 $AlGaN$ からなるp型クラッド層11とが順に積層されている。また、p型クラッド層11の表面には透光性電極12、p側電極13が順に形成され、第1のn型クラッド層3の表面にはn側電極14が形成されている。

【0044】この発光素子におけるMQWは、MOCVD法を用いて、以下の方法によって作製される。

【0045】まず、反応管内に十分洗浄したサファイアからなる基板1を装入し、反応管内に窒素と水素を流しながら、基板1を約1050°Cで10分間加熱し、基板1の表面のクリーニングを行う。

【0046】次に、基板1の温度を550°Cまで降下さ

せ、窒素、TMG、アンモニアをそれぞれ流してGaNバッファ層2を基板1の上に形成する。バッファ層2を形成後は、窒素とアンモニアをそれを流しながら基板1の温度を1050℃まで昇温し、この温度下において、窒素、水素、TMG、アンモニア、SiH₄をそれぞれ流して第1のn型GaNクラッド層3を形成する。第1のn型GaNクラッド層3を形成後は、引き続き1050℃において、窒素、水素、TMG、TMA、アンモニアをそれぞれ流して第2のn型AlGaNクラッド層4を形成する。

【0047】次に、水素、TMG、TMAの各供給を止めて、基板1の温度を750℃まで下げ、窒素、TMG、TMI、アンモニアをそれぞれ流して、InGaNからなる井戸層5を形成する。

【0048】その後、TMIの供給のみを止めて、引き続き、基板温度を750℃から1050℃まで昇温しながら障壁層Aを形成し、更に1050℃において、窒素、水素、TMG、アンモニアをそれぞれ流しながら、障壁層Bを形成し、障壁層Aと障壁層Bを合わせて障壁層6とする。次に、水素とTMGの供給を止め、基板1の温度を750℃まで下げる。あとは、井戸層5と障壁層6と同様の手順を繰返し、井戸層7、障壁層8、井戸層9、障壁層10を順次積層し、MQWを形成する。この方法によれば、井戸層の分解が抑制できると同時に、障壁層の結晶性を高めることができる。

【0049】本発明者らの知見によれば、障壁層Bの成長速度は障壁層Aの成長速度より大きくすることが望ましい。具体的には、障壁層Aの成長速度は0.01μm/h～0.5μm/hであるのに対し、障壁層Bの成長速度は0.1μm/h～10μm/hであることが好ましい。障壁層Bの成長速度が0.1μm/hよりも小さいとMQWの形成に時間がかかり過ぎるし、10μm/hより大きいと障壁層Bの結晶性が悪化する。障壁層の膜厚は井戸層に比較して厚く形成する必要があり、特に、障壁層Bの成長時に、障壁層Aよりも高い成長速度とすることによって、高温（概略一定温度）での成長速度が大きくなるので、障壁層の結晶性が向上すると同時に、障壁層を厚くする場合や、MQWの周期数を増やす場合に、成長時間を従来よりも短縮することができ、MQWからなる窒化物半導体の製造コストを低減できる。

【0050】次に、障壁層Bの成長時の雰囲気の水素濃度は障壁層Aの成長時の雰囲気の水素濃度よりも高くすることが望ましい。具体的には、障壁層Aの成長時の雰囲気の水素濃度が0%～5%であるのに対し、障壁層Bの成長時の雰囲気の水素濃度は5%～70%が好ましい。ここで、水素濃度は水素ガスの容量比である。障壁層Bの成長時の雰囲気の水素濃度が5%より低い場合は、障壁層Bの結晶性が悪化するし、70%以上では、基板面内での膜厚等の均一性が悪化する。

【0051】障壁層Aにおいては、井戸層の分解を抑制

することが重要となるため、障壁層の成長時の雰囲気の水素濃度は低い方が、井戸層の分解が抑えられる。これに対し、障壁層Bは障壁層の結晶性を向上させることが重要となるため、高温（1050℃）で障壁層Aよりも成長時の雰囲気の水素濃度を高めることにより、成長表面でのマイグレーションを促進し、障壁層の結晶性を向上させることができる。

【0052】次に、障壁層Bの成長時のV/III比は障壁層Aの成長時のV/III比よりも小さくすることが望ましい。具体的には、障壁層AのV/III比が1×10⁴～2×10⁵であるのに対し、障壁層BのV/III比は5×10²～1×10⁴が好ましい。障壁層BのV/III比が5×10²よりも小さい場合は、障壁層Bの成長時に成長表面での窒素分圧不足によりピット等が発生しやすくなり、1×10⁴以上になると成長表面の極性が窒素面となることにより障壁層Bの表面モフォロジーが悪化するようになる。

【0053】次に、MQWの井戸層はIn_xGa_{1-x}N（0<x<y）、障壁層はIn_yAl_{1-y}Ga_{1-y-z}N（0≤y<1、0≤z<1、0≤y+z<1、x>y）とすることが望ましい。井戸層の成長直後に昇温しながら障壁層の一部を成長させるので、障壁層の材料を窒化物半導体、すなわちIn_yAl_{1-y-z}N（0≤y<1、0≤z<1、0≤y+z<1、x>y）とすることにより、井戸層の劣化が抑制されると同時に、障壁層の結晶性も高めることができるため、発光特性のすぐれたMQWからなる窒化物半導体を作製することができる。

【0054】また、障壁層をGaNとすれば、障壁層の結晶性をさらに高めることができる。

【0055】次に、基板温度については、井戸層は500℃～900℃の範囲が望ましい。井戸層では、成長時においても分解が発生するので、900℃よりも高いとInGaNの分解が促進されて井戸層がほとんど成長しなくなり、500℃よりも低いと井戸層の結晶性が悪くなる。一方、昇温後の基板温度は800℃～1200℃が望ましい。基板温度がより高い方が障壁層の結晶性は向上するが1200℃よりも高いと、ウェハーの表面荒れが発生するし、MOCVD装置の基板加熱源への負荷も大きくなり、好ましくない。また、基板温度が800℃よりも低いと、十分な結晶性をもつ障壁層が成長できない。

【0056】次に、少なくとも障壁層Aの成長開始時のGaN原料供給量は井戸層のGaN原料供給量よりも少なくすることが望ましい。具体的には、井戸層成長時のTMG供給量が2μmol/l/分～10μmol/l/分であるのに対し、障壁層Aの成長開始時のTMG供給量は0.4μmol/l/分～4μmol/l/分が好ましい。障壁層Aの成長開始時のTMG供給量が0.4μmol/l/分よりも小さく、障壁層Aを成長させる際、井戸層の分解を抑制することが困難となるし、4μmol/l/分よりも大きい

と、障壁層Aの結晶性が悪化する。これは、障壁層AのTMG供給量を増やすと井戸層の分解は抑制され易くなるが、障壁層を低温で比較的速い成長速度で成長させることになるので、障壁層の結晶性がより悪化するためである。

【0057】また、障壁層Aを基板温度を昇温させながら成長させる際に、基板温度の上昇に伴い、障壁層Aの成長速度を徐々に速めることもできる。この場合、GaN原料供給量は障壁層Aの成長開始初期は0.4 μmol/分～4 μmol/分で、障壁層Aの成長終了直前では20 μmol/分～100 μmol/分とすることができる。

【0058】次に、井戸層を成長させる基板温度よりも高い基板温度で障壁層を成長した後、基板温度を井戸層を成長させる温度まで降温する際にも、少なくとも障壁層の一部を成長させることができ、成長時間短縮の点で望ましい。前記降温時は井戸層成長後の昇温時に比較して井戸層への影響（結晶性の劣化）が少なくなるため、前記昇温時に比較して、成長速度を早くできるという利点がある。なお、高温の方が障壁層の結晶性がよいことは明らかなるため、降温開始時の成長速度を早くし、温度の低下と共に徐々に成長速度を遅くすることも可能である。これにより、MQWの成長時間が短縮され、MQW発光層からなる窒化物半導体の製造コストを低減することができる。

【0059】次に、基板はサファイアやSiCを用い、その上にバッファ層を積層し、さらに窒化物半導体からなる下地層を成長させることにより、高い結晶性をもつ下地層を成長させることができ、その上に成長させるMQWの品質が向上するため、MQWからなる窒化物半導体の発光効率を高めることができる。

【0060】さらに、基板を窒化物半導体基板とすることができます。これにより、基板と下地層の格子定数差および熱膨脹係数差を従来よりも減らすことができ、窒化物半導体からなる下地層の結晶性をさらに高めることができる。これにより、前記下地層の上に成長させるMQWの品質がさらに向上するため、MQWからなる窒化物半導体の発光効率を高めることができる。

【0061】また、MQWの下地層は一般的にGaNが用いられており、基板をGaNとすることにより、基板と下地層が同一材料となり、さらに結晶性にすぐれた下地層を成長できるため、その上に積層するMQWの品質をさらに高めることができ、MQWからなる窒化物半導体の発光効率を高めることができる。

【0062】上記以外にもサファイア、SiC、GaN等の基板上に厚膜のGaNを積層したGaN積層基板を用いてもよいし、前記のGaN積層基板や前記の窒化物半導体基板上にSiO₂等のマスクでパターニングしたものと基板として用いても同様にMQWからなる窒化物半導体の発光効率を高めることができる。

【0063】

【実施例】以下、本発明のMQW構造をもつ窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法の具体例について図面を参考しながら説明する。

【0064】（実施例1）図2は、本発明の実施例1に係るMQWからなる窒化物半導体の層構造を表す断面図であり、図3は、本発明の実施例1に係るMQWからなる窒化物半導体の成長プロファイル（基板温度、成長速度、水素濃度、アンモニア流量）を示す図である。

【0065】先ず、表面を鏡面に仕上げられたサファイアの基板1をMOCVD装置の反応管内の基板ホルダーに載置した後、基板1の温度を1000℃に保ち、窒素を5リットル/分、水素を5リットル/分、で流しながら基板1を10分間加熱することにより、基板1の表面に付着している有機物等の汚れや水分を取り除いた。

【0066】次に、基板1の温度を550℃にまで降下させ、キャリアガスとして窒素を16リットル/分、アンモニアを4リットル/分、TMGを40 μmol/分、で供給して、GaNからなるバッファ層2を25nmの厚さで成長させた。

【0067】次に、TMGの供給のみを止めて基板1の温度を1050℃まで昇温させた後、キャリアガスとして窒素と水素を各々13リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを80 μmol/分、で供給して、アンドープのGaNからなる下地層22を2 μmの厚さで成長させた。

【0068】下地層22を成長後、TMGの供給を止め、基板1の温度を750℃にまで降下させ、この温度に維持して、キャリアガスとして窒素を14リットル/分、アンモニアを6リットル/分、TMGを4 μmol/分、TMIを5 μmol/分、で供給して、アンドープのIn_{0.15}Ga_{0.85}Nからなる量子井戸構造の井戸層5を2 nmの厚さで成長させた。

【0069】井戸層5を成長後、TMIの供給を止め、キャリアガスとして窒素を14リットル/分、アンモニアを6リットル/分、TMGを2 μmol/分で供給して、基板1の温度を1050℃に向けて昇温させながら、引き続きアンドープのGaN（障壁層A）を3 nmの厚さで成長させ、基板1の温度が1050℃に達したら、キャリアガスとして窒素と水素を各々15リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを2リットル/分、TMGを40 μmol/分、で供給して、引き続きアンドープのGaN（障壁層B）を12 nmの厚さで成長させた。こうしてアンドープのGaNからなる厚さ15 nmの障壁層6を形成した。そして、キャリアガスとして窒素を19リットル/分、アンモニアを1リットル/分で流しながら、基板温度を再度750℃にまで降下させ、井戸層5と障壁層6の製法と同様の手順を繰り返すことにより、井戸層7、障壁層8、井戸層9、障壁層10を形成した。

40

【0070】上記以外にもサファイア、SiC、GaN等の基板上に厚膜のGaNを積層したGaN積層基板を用いてもよいし、前記のGaN積層基板や前記の窒化物半導体基板上にSiO₂等のマスクでパターニングしたものと基板として用いても同様にMQWからなる窒化物半導体の発光効率を高めることができる。

50

【0070】障壁層10を成長後は、基板1の温度を1050℃に保ち、引き続き、キャリアガスとして窒素と水素を各々13リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを80μmol/分、で供給して、アンドープのGaNからなるキャップ層23を100nm成長させた。

【0071】このようにして、3層の井戸層からなるMQWを形成し、試料1とした。

【0072】(比較例1) 上記の実施例1の製造方法の中のMQWを形成する工程において、下地層22を成長後、TMGの供給を止め、基板1の温度を750℃にまで降下させ、750℃において、キャリアガスとして窒素を14リットル/分、アンモニアを6リットル/分、TMGを4μmol/分、TMIを5μmol/分、で供給して、アンドープのIn0.15Ga0.85Nからなる単一量子井戸構造の井戸層5を2nmの厚さで成長させた。次に、基板温度は750℃のまま保持し、キャリアガスとして窒素を14リットル/分で流しながら、アンモニアを6リットル/分、TMGを2μmol/分で供給してアンドープのGaNを15nmの厚さで成長させ、障壁層6とした。

【0073】以降、井戸層5と障壁層6の製法と同様の手順を繰り返すことにより、井戸層7、障壁層8、井戸層9、障壁層10を順次に形成した。

【0074】次に、キャリアガスとして窒素を14リットル/分、アンモニアを1リットル/分で流しながら、基板1の温度を1050℃まで昇温させ、昇温後はキャリアガスとして窒素と水素を各々13リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを80μmol/分、で供給してキャップ層23を100nm積層した。

【0075】このようにして、実施例1と同一構造の3層の井戸層からなるMQWを形成し、試料2とした。

【0076】まず、実施例1の試料1と、比較例1の試料2についてフォトルミネッセンス(PL)測定装置を用いて光学特性の比較を行なった。PL測定装置に用いた励起光はHe-Cdレーザ(波長325nm)で、励起強度は10mWとした。

【0077】図4は、試料1および試料2のフォトルミネッセンススペクトルを示す図である。試料1のPLスペクトル31は試料2のPLスペクトル32に比較して約4倍の発光強度であった。これは、試料1の方がより高い温度で障壁層を成長したので、MQWの結晶性が向上したためと考えられる。また、昇温後(1050℃の一定温度)に障壁層の成長速度を20倍に高めることにより、試料1のMQWの成長時間が試料2よりも約30分間短縮できた。

【0078】(実施例2) 本発明の第2の実施例である窒化物半導体を用いた発光素子の製造方法について図1を参照しながら説明する。

【0079】先ず、表面を鏡面に仕上げられたサファイアの基板1をMOCVD装置の反応管内の基板ホルダーに載置した後、基板1の温度を1000℃に保ち、窒素を5リットル/分、水素を5リットル/分、で流しながら基板を10分間加熱することにより、基板1の表面に付着している有機物等の汚れや水分を取り除いた。

【0080】次に、基板1の温度を550℃にまで降下させ、キャリアガスとして窒素を16リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを40μmol/分、で供給して、アンドープのGaNからなるバッファ層2を25nmの厚さで成長させた。

【0081】次に、TMGの供給を止めて1050℃まで昇温させた後、キャリアガスとして窒素と水素を各々13リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを80μmol/分、10ppm希釈のSiH4を10cc/分、で供給して、SiをドープしたGaNからなる第1のn型クラッド層3を2μmの厚さで成長させた。

【0082】第1のn型クラッド層3を成長後、基板1の温度を1050℃に保ち、キャリアガスとして窒素と水素を各々15リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを2リットル/分、TMGを40μmol/分、TMAを3μmol/分、で供給して、アンドープのAl0.05Ga0.95Nからなる第2のn型クラッド層4を20nmの厚さで成長させた。

【0083】第2のn型クラッド層4を成長後、TMGとSiH4の供給を止め、基板温度を750℃にまで降下させ、750℃において、キャリアガスとして窒素を14リットル/分で流しながら、アンモニアを6リットル/分、TMGを4μmol/分、TMIを5μmol/分、で供給して、アンドープのIn0.15Ga0.85Nからなる量子井戸構造の井戸層5を2nmの厚さで成長させた。

【0084】井戸層5を成長後、TMIの供給を止め、キャリアガスとして窒素を14リットル/分、アンモニアを6リットル/分、TMGを2μmol/分で供給して、基板1の温度を1050℃に向けて昇温せながら、引き続きアンドープのGaN(障壁層A)を3nmの厚さで成長させ、基板1の温度が1050℃に達したら、キャリアガスとして窒素と水素を各々15リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを2リットル/分、TMGを40μmol/分、で供給して、引き続きアンドープのGaN(障壁層B)を12nmの厚さで成長させた。こうしてアンドープのGaNからなる厚さ15nmの障壁層6を形成した。そして、キャリアガスとして窒素を19リットル/分、アンモニアを1リットル/分で流しながら、基板温度を再度750℃にまで降下させ、井戸層5と障壁層6の製法と同様の手順を繰り返すことにより、井戸層7、障壁層8、井戸層9、障壁層10を順に形成した。

【0085】障壁層10を形成後は、基板1の温度を1050℃に保ち、引き続き、キャリアガスとして窒素と水素を各々1.5リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを2リットル/分、TMGを4.0μmol/分、TMAを3μmol/分、Cp2Mgを0.4μmol/分で供給して、MgをドープさせたAl0.05Ga0.95Nからなるp型クラッド層11を0.2μmの厚さで成長させた。

【0086】p型クラッド層11を成長後、TMGとTMAとCp2Mgの供給を止め、窒素を1.8リットル/分、アンモニアを2リットル/分で流しながら、基板の温度を室温程度にまで冷却させて、基板の上に窒化物半導体が積層されたウェハーを反応管から取り出した。

【0087】尚、有機金属化合物であるTMGと、TMIと、TMAと、Cp2Mgはすべて水素キャリアガスによって気化することで、反応管に供給した。

【0088】このようにして形成した窒化ガリウム系化合物半導体からなる積層構造に対して、別途アニールを施すことなく、その表面上に、蒸着法により、ニッケル(Ni)と金(Au)をそれぞれ5nmの厚さで全面に積層した後、フォトリソグラフィ法とウェットエッチング法により、透光性電極12を形成した。

【0089】この後、透光性電極12と露出したp型クラッド層11の上にCVD法によりSiO₂からなる絶縁膜(図示せず)を0.5μmの厚さで堆積させ、フォトリソグラフィ法と反応性イオンエッティング法により、透光性電極12を覆うと同時にp型クラッド層11の表面の一部を露出させる絶縁膜からなるマスクを形成した。

【0090】次に、上記のマスクを用いて、塩素系ガスを用いた反応性イオンエッティング法により、露出させたp型クラッド層11の表面側から、p型クラッド層11とMQW層(5~10)と第2のn型クラッド層4を約0.4μmの深さで除去して、第1のn型クラッド層3の表面を露出させた。

【0091】上記の工程の後、一旦、絶縁膜をウェットエッティング法により除去して、蒸着法およびフォトリソグラフィ法により、透光性電極12の表面上の一部と、露出させた第1のn型クラッド層3の表面の一部とに、0.1μm厚のチタン(Ti)と0.5μm厚のAuを積層して、それぞれp側電極13とn側電極14とした。その後、プラズマCVD法とフォトリソグラフィ法により、透光性電極12の表面を被覆する0.2μm厚のSiO₂からなる絶縁性膜(図示せず)を形成した。

【0092】この後、サファイアの基板1の裏面を研磨して100μm程度にまで薄くし、スクライブによりチップ状に分離した。このチップを電極形成面側を上向きにしてシステムに接着した後、チップのp側電極13とn側電極14をそれぞれシステム上の電極にワイヤで結線し、その後樹脂モールドして発光素子を作製し、試料3

とした。この発光素子を20mAの順方向電流で駆動したところ、ピーク波長470nmの青色で発光した。このときの発光出力は4mWであり、順方向動作電圧は3.8Vであった。

【0093】(実施例3)本発明の第3の実施例である窒化物半導体を用いた発光素子の製造方法について図面を参照しながら説明する。

【0094】図5は本発明の実施例3に係るMQW構造をもつ窒化物半導体からなる発光素子の層構造を表す断面図である。

【0095】実施例2に示したMQW構造をもつ窒化物半導体からなる発光素子において、基板が窒化物半導体の場合について試作し、発光出力を調べた。例として、窒化物半導体基板がGaNである発光素子を作製した。基板は、HYPE法(ハイドライド気相成長)により、サファイア基板上に100μm厚のGaNを積層した後、基板表面の凹凸を除去するために、ダイヤモンドスライサーを用いて深さ10μmの研磨を行なった。研磨後は、GaN表面に発生した機械加工によるダメージ層を除去し、最後にサファイア基板を除去してGaN基板21とした。GaN基板21は研磨時の潤滑油、ワックス等の有機物や不純物を除去するため、有機洗浄および超純水洗浄を実施し、乾燥後に、MOCVD装置の反応管内の基板ホルダーに載置した。

【0096】まず、GaN基板21の温度を室温から直接1050℃まで昇温させた後、キャリアガスとして窒素と水素を各々1.3リットル/分と3リットル/分で流しながら、アンモニアを4リットル/分、TMGを8.0μmol/分、10ppm希釈のSiH₄を10cc/分で供給して、SiをドープしたGaNからなる第1のn型クラッド層3を2μmの厚さで成長させた。

【0097】その後は、実施例2と同様の成長手順により、第2のn型クラッド層4、井戸層5、障壁層6、井戸層7、障壁層8、井戸層9、障壁層10、MgドープAlGaNクラッド層11を順次に積層し、電極プロセスとして透光性電極12、p側電極13、n側電極14を形成して発光素子を作製し、試料4とした。この発光素子を20mAの順方向電流で駆動したところ、ピーク波長470nmの青色で発光した。このときの発光出力は4mWであり、順方向動作電圧は3.4Vであった。

この場合、発光出力は実施例2で示したサファイア基板を用いた発光素子(試料3)と同等レベルのものが得られている。これより、基板がGaNの場合、実施例2と同様に発光素子の発光効率が大幅に向上し、順方向動作電圧がさらに低減されることを確認した。

【0098】なお、以上説明した実施の形態では主として発光ダイオードに適用した例を説明したが、本発明は発光ダイオードに限らず、窒化物半導体を用いた半導体レーザ等の各種の半導体素子に適用することも可能である。

【0099】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、多重量子井戸構造(MQW)からなる窒化物半導体において、井戸層成長直後に基板を昇温しながら障壁層を成長させることによって、井戸層の劣化を抑制すると同時に、障壁層の結晶性を向上させることができ、前記窒化物半導体からなる発光素子における発光効率を向上させることができるという優れた効果が得られる。

【0100】また、障壁層を厚く形成したり、MQWの周期数を増やしたりする場合に、MQW発光層の形成時間を従来よりも短縮化することができ、窒化物半導体からなる発光素子の製造コストを低減することが可能となる。

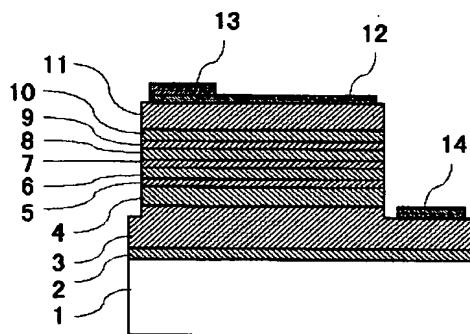
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係るMQWからなる窒化物半導体発光素子の層構造を表す断面図

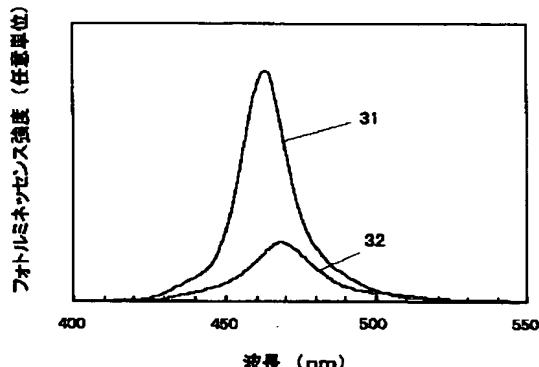
【図2】本発明の実施例1に係るMQWからなる窒化物半導体の層構造を表す断面図

【図3】本発明の実施例1に係るMQWからなる窒化物半導体の成長プロファイル(基板温度、成長速度、水素濃度、アンモニア流量)を示す図

【図1】



【図4】



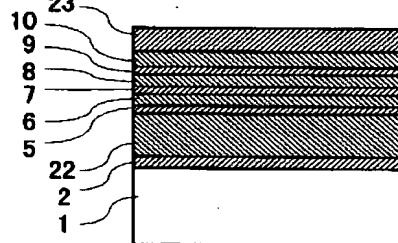
【図4】試料1および試料2のフォトルミネッセンススペクトルを示す図

【図5】本発明の実施例3に係るMQW構造をもつ窒化物半導体からなる発光素子の層構造を表す断面図

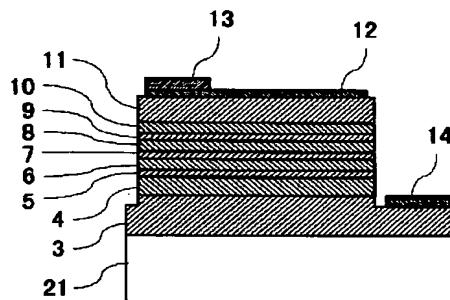
【符号の説明】

1	基板
2	バッファ層
3	第1のn型クラッド層
4	第2のn型クラッド層
5、7、9	井戸層
6、8、10	障壁層
11	p型クラッド層
12	透光性電極
13	p側電極
14	n側電極
21	GaN基板
22	下地層
23	キャップ層
31	試料1のPL強度
32	試料2のPL強度

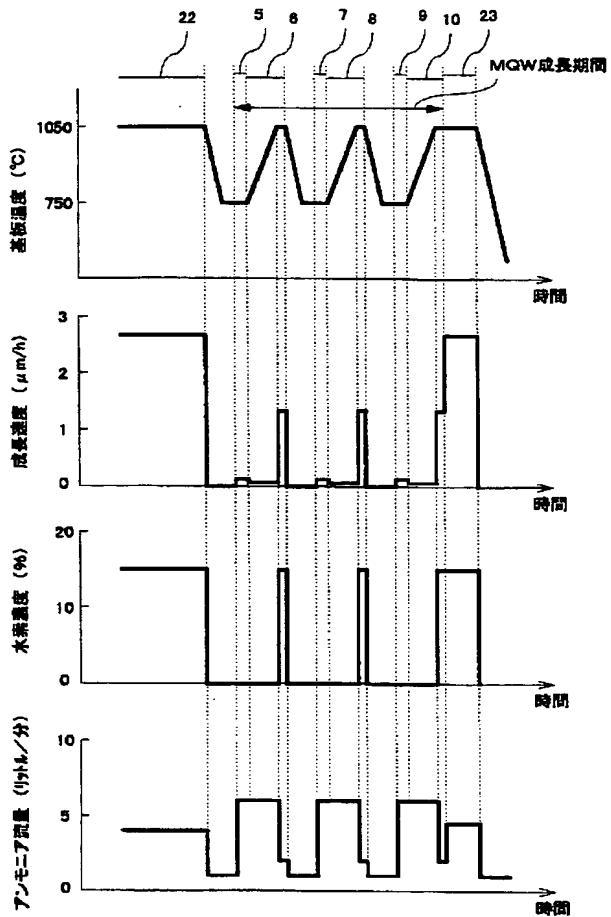
【図2】



【図5】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 品川 修一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

F ターム(参考) 4K030 AA11 AA13 AA17 AA18 BA08

BA11 BA38 BB12 CA04 CA05

DA03 FA10 HA01 JA06 JA10

JA12 LA11 LA12 LA18

5F041 AA03 AA40 CA05 CA33 CA34

CA40 CA46 CA57 CA65 CA74

CA82 CA88 CA92 DA07

5F045 AA04 AB17 AB18 AC01 AC08

AC12 AC19 AD09 AD10 AD11

AD12 AD13 AD14 AD15 AD16

AF02 AF04 AF09 BB12 BB13

CA10 CA12 DA53 DA55 EE12

EK27 EK28

5F073 AA74 CA07 CB05 CB07 DA05

DA25 DA35 EA28

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.